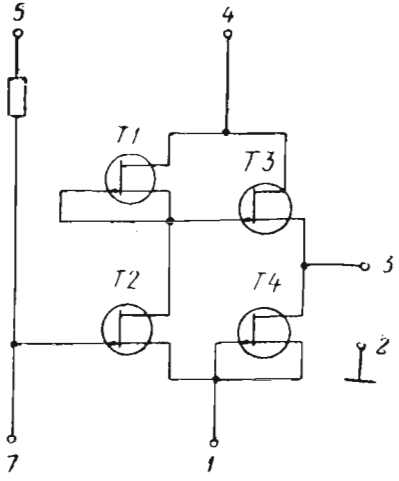
УСИЛИТЕЛЬ	504УН1А— 504УН1В

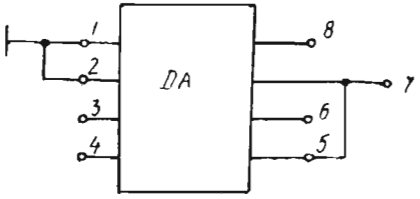
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

1 — общий
2 — корпус
3 — выход
4 — минус 12 В



5 — вход 2
6 — свободный
7 — вход 1
8 — свободный

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25±5°С)

Напряжение питания, В	минус 12±10%
Ток потребления, мА, не более	5
Коэффициент усиления напряжения для микросхем:	
504УН1А	от 20 до 60
504УН1Б	от 40 до 120
504УН1В	от 80 до 200

Напряжение шумов, приведенное ко входу, мкВ, не более	3
Максимальное выходное напряжение, В, не менее	0,5

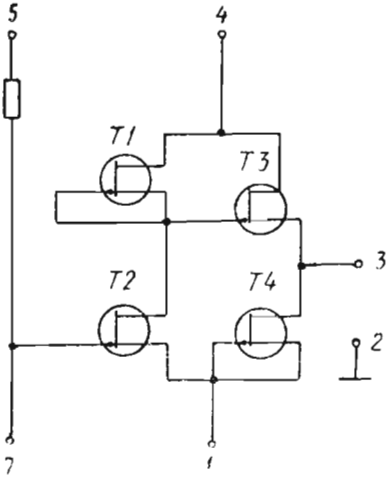
Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации

Максимальное напряжение питания, В	минус 13,2
Предельное входное напряжение, В	от минус 0,3 до +2,0
Минимальная активная нагрузка, кОм	30
Минимальная реактивная нагрузка, кОм	3

УСИЛИТЕЛЬ	504УН2А— 504УН2В

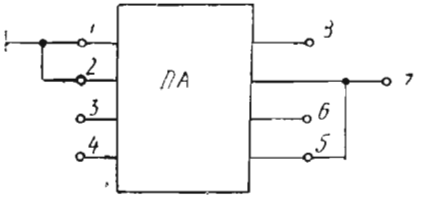
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

1 — общий
2 — корпус
3 — выход
4 — минус 12 В



5 — вход 2
6 — свободный
7 — вход 1
8 — свободный

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25±5°С)

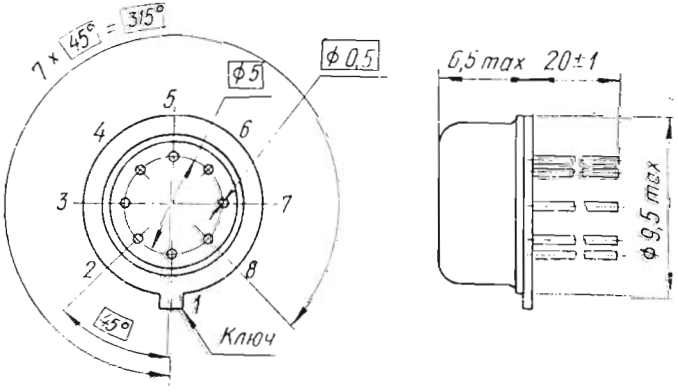
Напряжение питания, В	минус 12±10%
Ток потребления, мА, не более	5
Коэффициент усиления напряжения для микросхем:	
504УН2А	от 20 до 60
504УН2Б	от 40 до 120
504УН2В	от 80 до 200

Напряжение шумов, приведенное ко входу, мкВ, не более	5
Максимальное выходное напряжение, В, не менее	0,5

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации

Максимальное напряжение питания, В	минус 13,2
Предельное входное напряжение, В	от минус 0,3 до +2,0
Минимальная активная нагрузка, кОм	30
Минимальная реактивная нагрузка, кОм	3

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ



Масса не более 1,5 г

Смещение осей выводов от номинального расположения контролируется в плоскости основания корпуса.

Нумерация выводов микросхем показана условно.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, м·с$^{-2}$ (g)	400 (40)
Механический удар:	
одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, м·с$^{-2}$ (g) . . .	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0
многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, м·с$^{-2}$ (g) . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, м·с$^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	170
Атмосферное пониженное давление, (Па) мм рт. ст.	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С	125

Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменения температуры среды, °С	от минус 60 до +125

Иней, роса.
Соляной туман.
Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11.073.041—82, ОСТ 11.073.040—82 и требованиями, изложенными ниже.

Пайку выводов следует производить заземленным паяльником мощностью не более 40 Вт с температурой жала не более 265°С в течение не более 3 с. Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 5 мм.

При применении микросхем 504УН1, 504УН2 закорачиванием выводов *5* и *1* можно использовать внутреннее сопротивление величиной 0,3—4 МОм в качестве сопротивления утечки затвора входного транзистора. Если внутреннее сопротивление микросхемы не используется, то необходимо закорачивать выводы *5* и *7*.

Транзисторы сохраняют свои усилительные свойства до частот порядка 1—2 МГц.

Следует принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру корпуса микросхемы и защиту от воздействия климатических факторов. Для этого рекомендуется улучшать вентиляцию, рационально размещать схемы в блоках, применять теплоотводные панели и экраны, заливать компаундами и покрывать лаками.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.